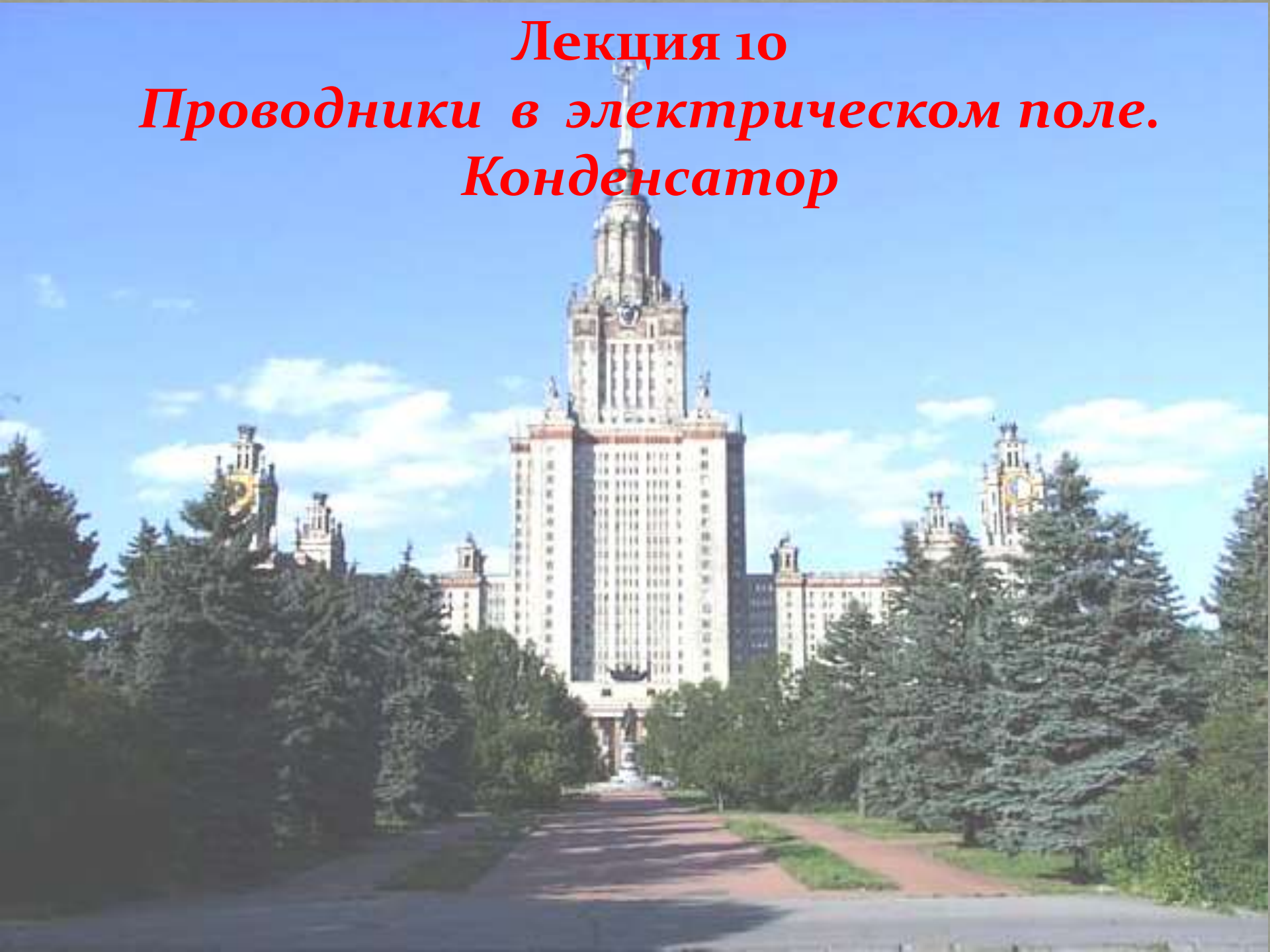


**Лекция 10**  
***Проводники в электрическом поле.***  
***Конденсатор***



# § 10. Проводники в электрическом поле

## 10.1. Поле заряженного проводника

- 1. Напряжённость электрического поля в проводниках равна нулю;

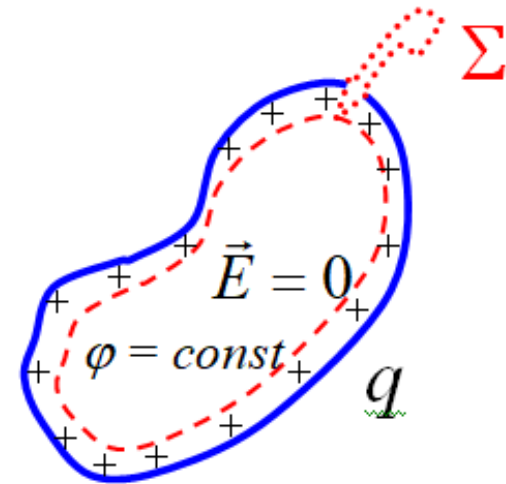
$$\vec{E}^{(\text{внутри})} = 0;$$

- 2. Потенциал всех точек проводящего тела одинаков  $\varphi = \text{const}$ ;

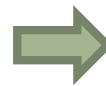
$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi \Rightarrow \varphi = \text{const};$$

$$\left( \text{или: } E_l = \frac{\partial \varphi}{\partial l} \right)$$

- 3. Весь избыточный заряд проводника распределён по его поверхности;



$$\Phi_E = \oint_{\Sigma} (\vec{E}, d\vec{S}) = 0$$



$$\Sigma q^{(\text{внутри})} = 0 \quad !!$$

“любая поверхность  $\Sigma$  внутри”

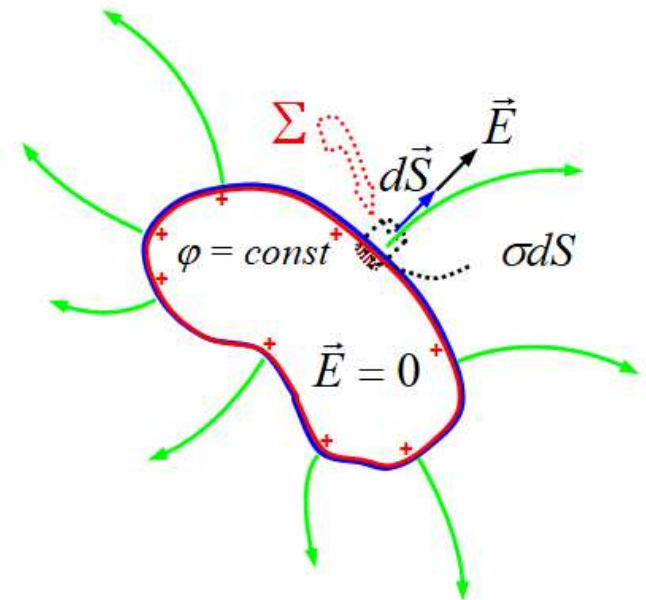
## Поле снаружи вблизи поверхности проводника ??

- 4. Вне проводника силовые линии электростатического поля вблизи от его поверхности перпендикулярны к ней;
- 5. Напряжённость поля заряженного проводника вблизи поверхности пропорциональна поверхностной плотности заряда;

$$\Phi_E = \oint_{\Sigma} (\vec{E}, d\vec{S}) = E \cdot dS$$

$$E \cdot dS = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \sigma \cdot dS.$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}$$

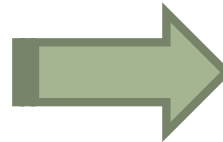


$\sigma \sim ?$

- 6\*. Плотность поверхностного заряда проводника зависит от её кривизны;

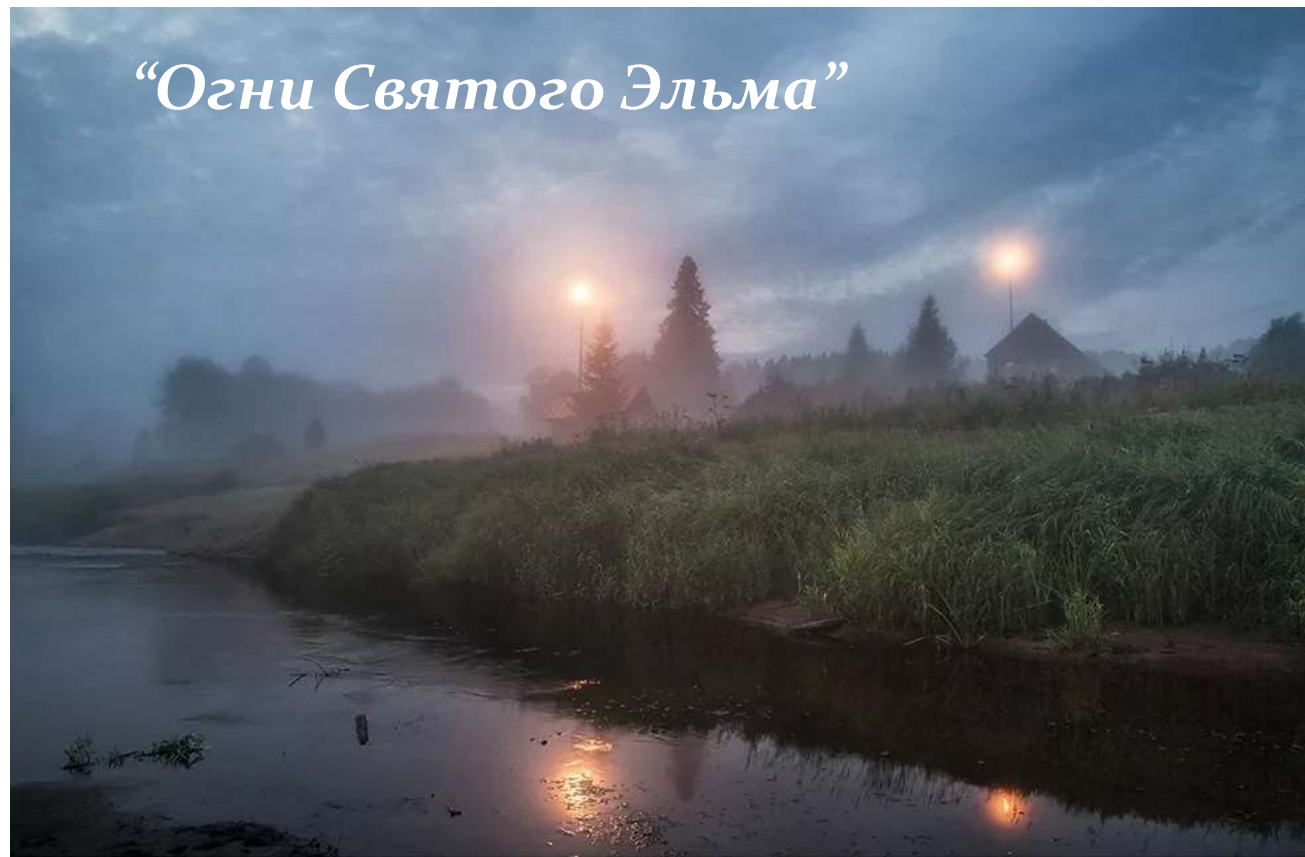
$$\sigma \sim \frac{1}{R_{кр}} \Rightarrow$$

$$E \sim \frac{1}{R_{кр}}$$



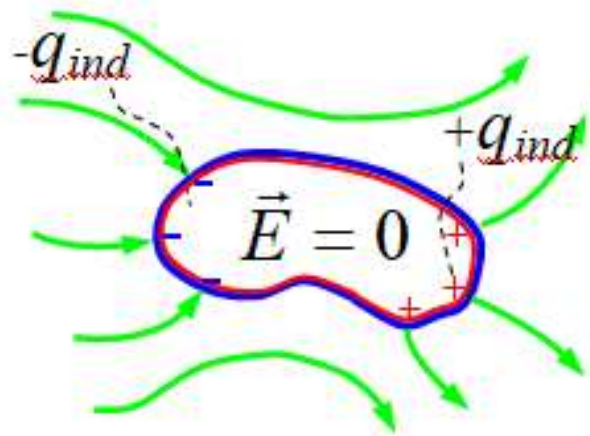
“Огни Святого Эльма”

# *“Огни Святого Эльма”*

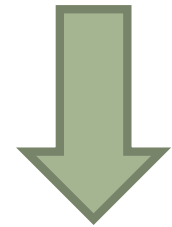
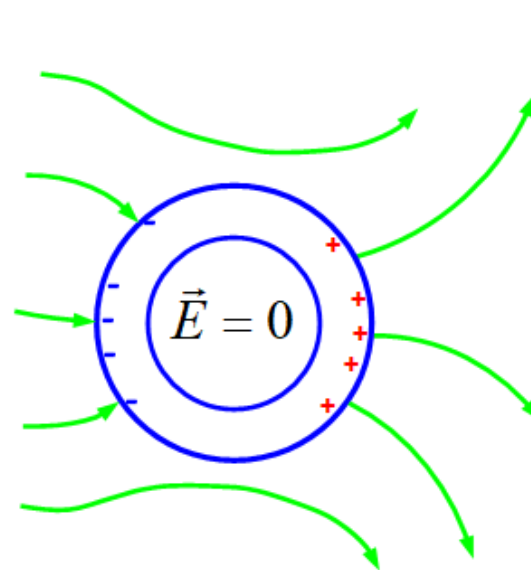


А ещё  
*“Туннельный микроскоп”*

## 10.2. Проводники во внешнем электрическом поле (Проводящие оболочки. Теоремы Фарадея)



“Электростатическая защита”



“Клетка Фарадея”

- 1. Если внутри полости проводящей оболочки нет заряженных тел, то эта область пространства свободна от электрического поля

*“Электростатическая защита”*

*Шоу “Клетка Фарадея”*

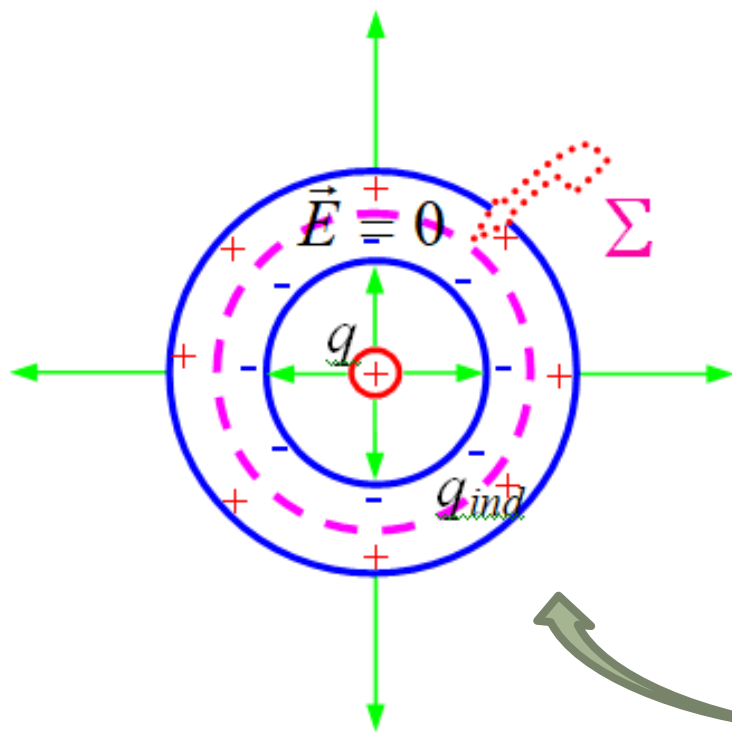


# “Клетка Фарадея”

# “Электростатическая защита”



- 2. Суммарный заряд, индуцированный на внутренней поверхности полости, равен алгебраической сумме зарядов, находящихся внутри полости проводника, взятой с противоположным знаком



$$\oint_{\Sigma} (\vec{E}, d\vec{S}) = \frac{1}{\epsilon_0} \left( \sum_i q_i + q_{ind} \right) \Rightarrow$$

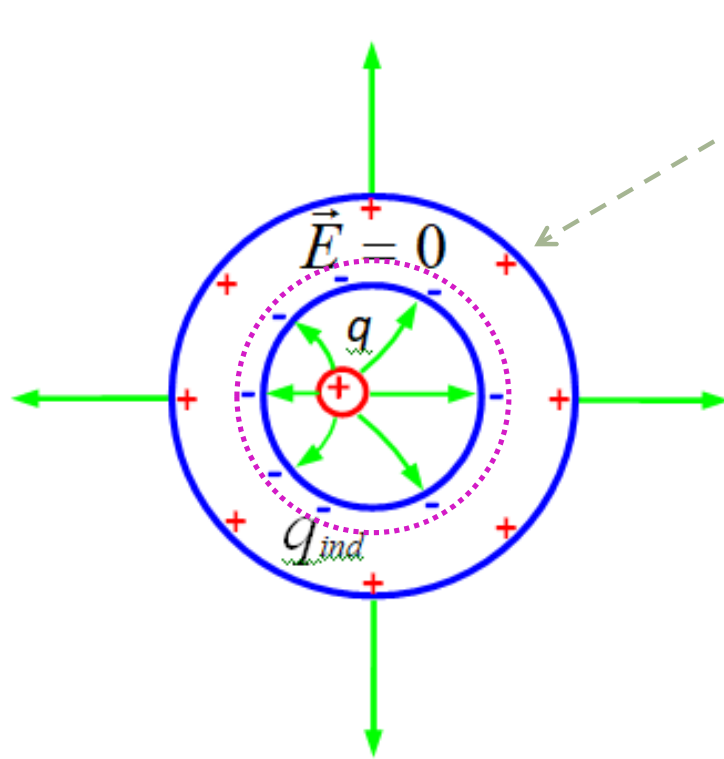
$$= 0!$$

алгебраическая сумма зарядов  
внутри полости –  $\sum_i q_i$

индуцированный на  
внутренней поверхности заряд –  $q_{ind}$

$$q_{ind} = -\sum_i q_i$$

- 3. Индукционный заряд на внешней поверхности оболочки, равен по модулю и противоположен по знаку заряду, индуцированному на внутренней её поверхности



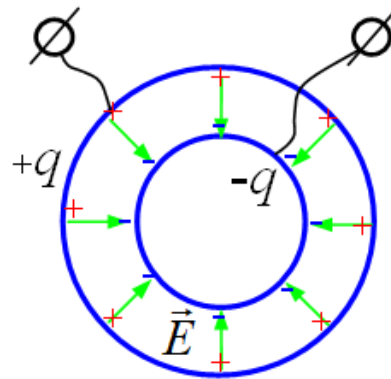
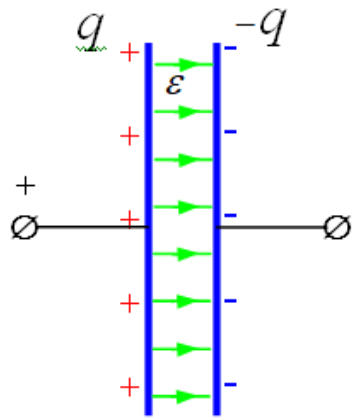
$$q_{ind} = - \left( \sum_{\text{внутр. пов.}} q_i \right)$$

Оболочка НЕ экранирует внешнюю область пространства от заряда внутри

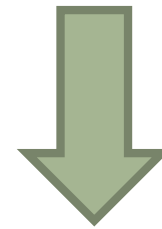
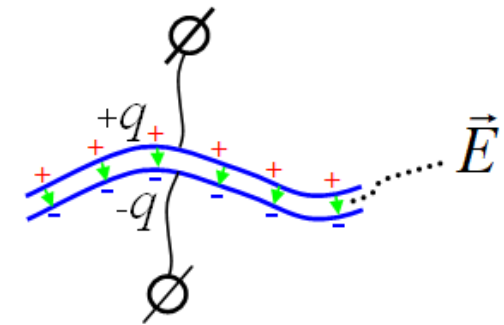


## 10.3. Конденсаторы. Электроёмкость конденсаторов

“Конденсатор” ?? – копить заряд / сгущать поле  
(конденсировать)



...

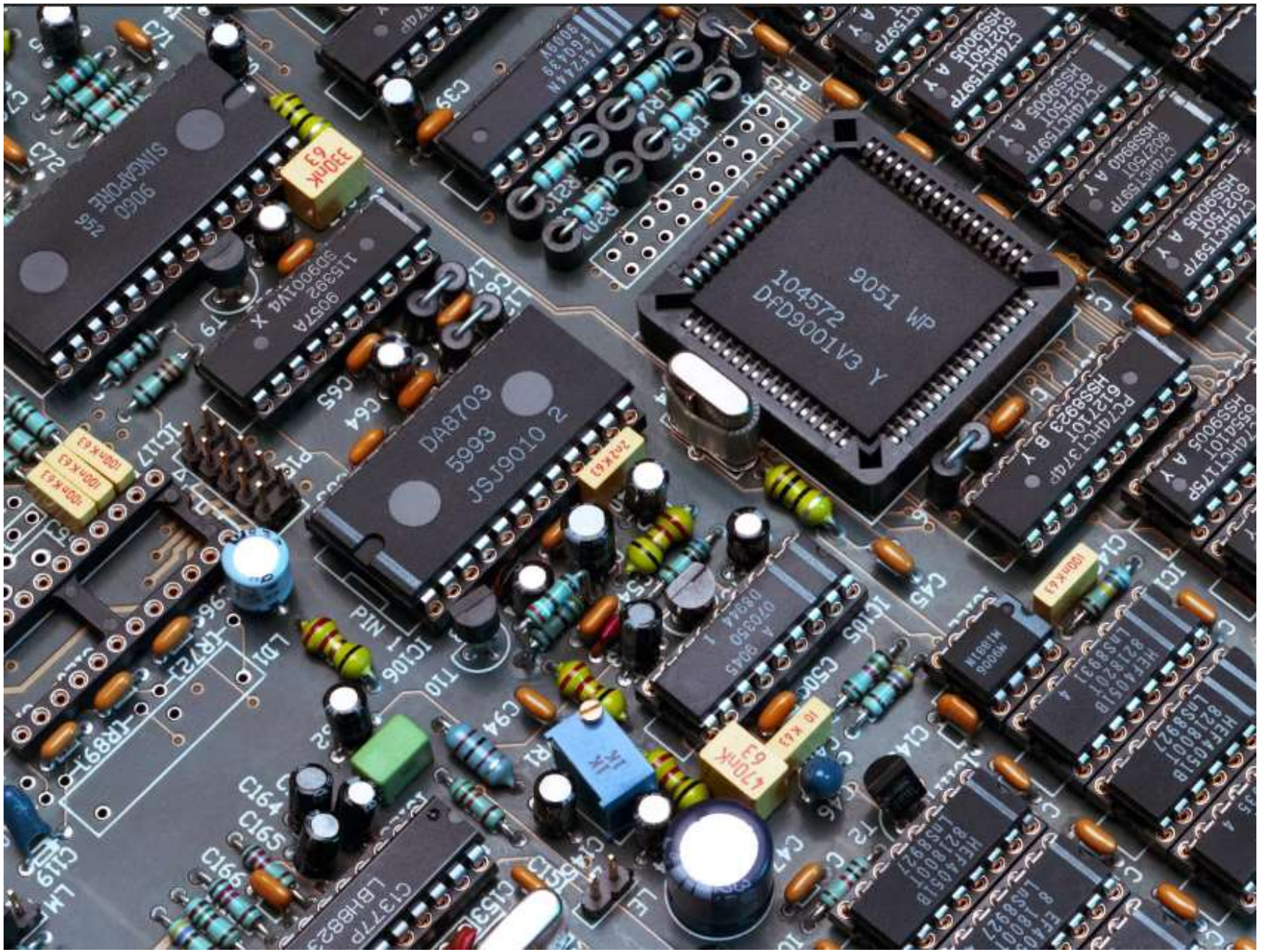


➡ (Опр.) Конденсатором называется система, состоящая из двух проводников, между которыми возникает изолированное от внешних тел электрическое поле при сообщении проводникам равных по модулю и противоположных по знаку зарядов

# Конденсаторы



# “Печатная плата”





# “Электроёмкость” ??

– характеризует способность  
копить заряд:

► (Опр.) Электроёмкостью конденсатора называется отношение модуля заряда каждой из его обкладок к разности потенциалов между ними



$V, \text{ л?}$

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}$$

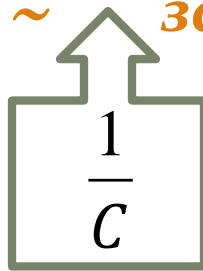
$$\frac{\dots \text{ Кл}}{1 \text{ В}} = \dots \Phi$$

“Фарада”

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{(1)}^{(2)} (\vec{E}, d\vec{l})$$

Нет зависимости от  
окружающих тел !!

$$\int_{(1)}^{(2)} (\vec{E}, d\vec{l})$$



~ заряд на обкладках ( $q$ )

- 1. Размеры;
- 2. форма;
- 3. расстояние между обкладками;
- 4. диэлектрическая проницаемость ( $\epsilon$ )

А ещё ??

# Как рассчитать ёмкость конденсатора ??

- 1. Найти напряжённость поля между обкладками  $\vec{E}(\vec{r})$  ;
- 2. разность потенциалов между обкладками выразить через  $q$ :

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{(1)}^{(2)} (\vec{E}, d\vec{l})$$

- 3. применить определение ёмкости:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}$$

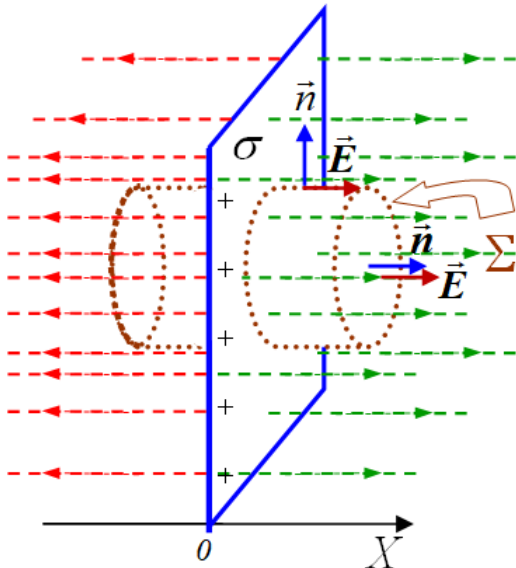
## Как считать на практике ?

**Пример:** (Задача 7.14,а) Рассчитать ёмкость плоского конденсатора с площадью пластин  $S$  и расстоянием  $d$  между ними. Конденсатор заполнен диэлектриком с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon$ .

- 1. Найти напряжённость поля между обкладками:

$$\oint_{\Sigma} \vec{E}_n dS = E \cdot 2S_{\text{осн.}} \Rightarrow E \cdot 2S_{\text{осн.}} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \sigma \cdot S_{\text{осн.}}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}$$



# Вернём вторую пластину “на место”:

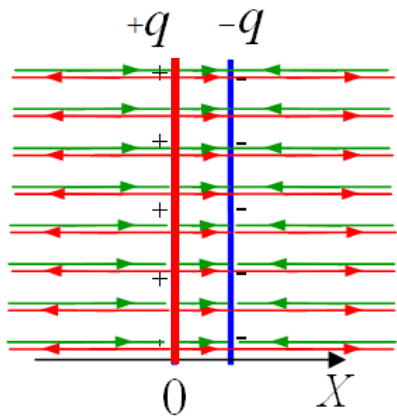
$$\vec{E}^{\text{вне}} = \vec{E}^{(+)} + \vec{E}^{(-)} = 0 \quad \text{— поле вне конденсатора;}$$

$$\vec{E}^{\text{внутри}} = \vec{E}^{(+)} + \vec{E}^{(-)} = 2\vec{E}^{(+)} = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} \vec{e}_+ + \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} \vec{e}_+$$

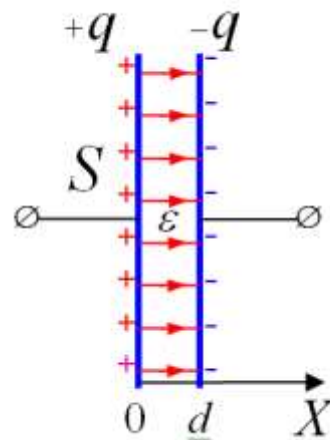
**Суперпозиция полей**

поле внутри

“пустого” конденсатора



$$E = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0}$$



$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{(1)}^{(2)} E_l dl = \int_0^d E_x dx = \int_0^d \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0} dx = \frac{\sigma \cdot d}{\epsilon\epsilon_0}$$

$$C_0 = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{\sigma \cdot d / \epsilon\epsilon_0} = \frac{\epsilon\epsilon_0 S \cdot q}{q \cdot d}$$

**И вот результат:**

$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d}$$

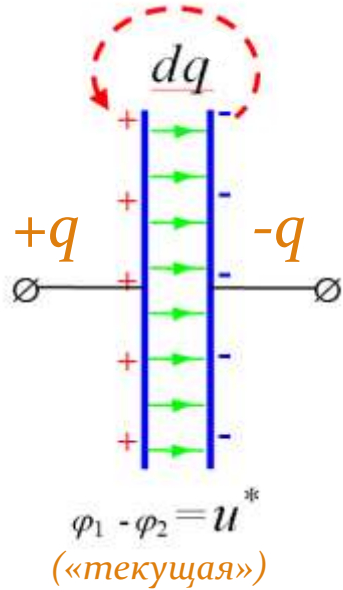


Энергия заряженного конденсатора  $\equiv$  Энергия электрического поля



# 10.3. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля

$$\frac{Cu^2}{2} \quad ??$$



$$dA = dq \cdot (\varphi_2 - \varphi_1)^* = dq \cdot u^* = \left\{ C = \frac{q^*}{u^*} \right\} = dq \cdot \frac{q^*}{C}$$

$$W_{\text{э}} = \frac{q^2}{2C}$$

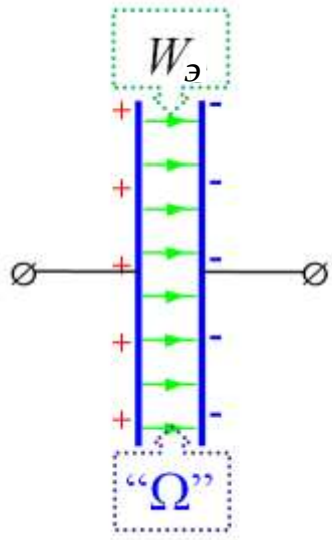
или  $W_{\text{э}} = \frac{Cu^2}{2}$

$$A = \int_0^q \frac{q^*}{C} dq^* = \frac{q^2}{2C}$$

копить заряд / сгущать поле → копить энергию !!

$$W_{\text{э}} = \frac{Cu^2}{2} = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d} \cdot \frac{(Ed)^2}{2} = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2} \cdot Sd = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2} \cdot V$$

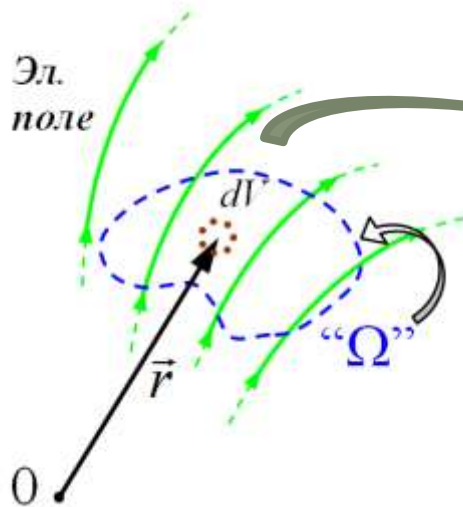
# Энергия заряженного конденсатора $\equiv$ Энергия электрического поля



$$W_э = \frac{Cu^2}{2} = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d} \cdot \frac{(Ed)^2}{2} = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2} \cdot Sd = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2} \cdot V \quad ??$$

*плотность энергии электрического поля*

$$w_э = \frac{\delta W_э}{dV} \Rightarrow w_э = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2} \quad !!$$



$$w_э = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2(\vec{r})}{2} \Rightarrow$$

$$W_э = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{2} \int_{\Omega} E^2(\vec{r}) dV$$

# Применение конденсаторов

50. Энергия заряженного конденсатора

